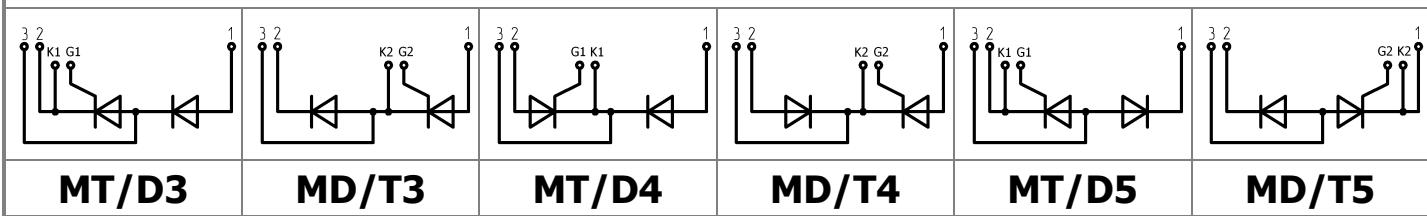
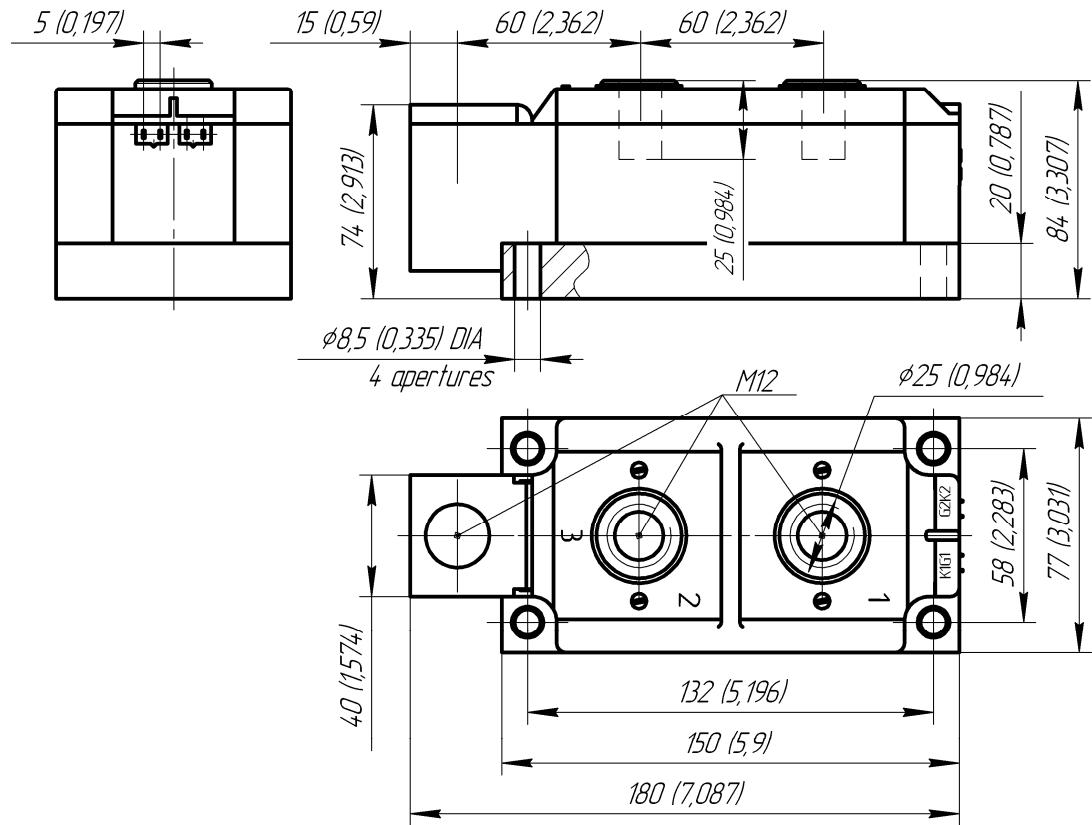
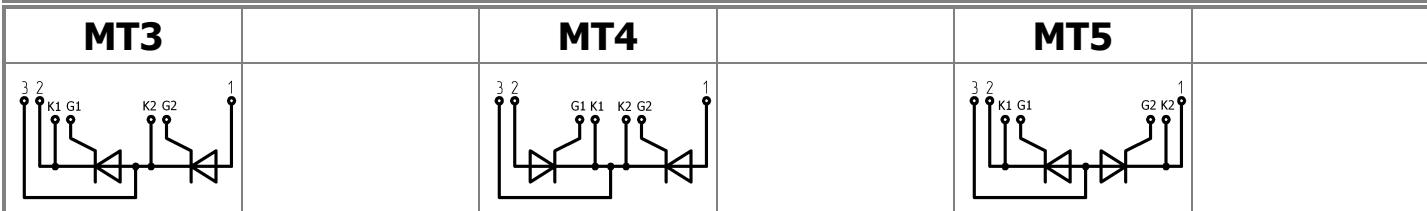


Изолированное основание  
 Корпус промышленного стандарта  
 Упрощенная механическая конструкция,  
 быстрая сборка  
 Прижимная конструкция

## Двухпозиционный Тиристорный Модуль МТх-500-36-D

Средний прямой ток	$I_{TAV}$	500 A		
Повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	$U_{DRM}$	3000 ÷ 3600 В		
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	$U_{RRM}$			
Время выключения	$t_q$	400 мкс		
$U_{DRM}$ , $U_{RRM}$ , В	3000	3200	3400	3600
Класс по напряжению	30	32	34	36
$T_J$ , °C	$-40 \div 125$			



Все размеры в миллиметрах (дюймах)

## ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Обозначение и наименование параметра		Ед. изм.	Значение	Условия измерения	
<b>Параметры в проводящем состоянии</b>					
I <sub>TAV</sub>	Средний ток в открытом состоянии	A	500	T <sub>c</sub> = 85 °C;	
I <sub>TRMS</sub>	Действующий ток в открытом состоянии	A	785	180 эл. град. синус; 50 Гц	
I <sub>TSM</sub>	Ударный ток в открытом состоянии	kA	18.0 21.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс
			19.0 22.0	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс
I <sup>2</sup> t	Защитный фактор	A <sup>2</sup> ·10 <sup>3</sup>	1620 2205	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс
			1495 2005	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> T <sub>j</sub> =25 °C	180 эл. град. синус; 60 Гц (t <sub>p</sub> =8.3 мс); единичный импульс; U <sub>D</sub> =U <sub>R</sub> =0 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс
<b>Блокирующие параметры</b>					
U <sub>DRM</sub> , U <sub>RRM</sub>	Повторяющееся импульсное обратное напряжение и повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	3000÷3600	T <sub>j min</sub> < T <sub>j</sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; управление разомкнуто	
U <sub>DSM</sub> , U <sub>RSM</sub>	Неповторяющееся импульсное обратное напряжение и неповторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии	V	3100÷3700	T <sub>j min</sub> < T <sub>j</sub> <T <sub>j max</sub> ; 180 эл. град. синус; 50 Гц; единичный импульс; управление разомкнуто	
U <sub>D</sub> , U <sub>R</sub>	Постоянное обратное и постоянное прямое напряжение	V	0.75·U <sub>DRM</sub> 0.75·U <sub>RRM</sub>	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ; управление разомкнуто	
<b>Параметры управления</b>					
I <sub>FGM</sub>	Максимальный прямой ток управления	A	8	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub>	
U <sub>RGM</sub>	Максимальное обратное напряжение управления	V	5		
P <sub>G</sub>	Максимальная рассеиваемая мощность по управлению	Вт	4	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> для постоянного тока управления	
<b>Параметры переключения</b>					
(di <sub>T</sub> /dt) <sub>crit</sub>	Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии (f=1 Hz)	A/мкс	400	T <sub>j</sub> =T <sub>j max</sub> ; U <sub>D</sub> =0.67·U <sub>DRM</sub> ; I <sub>TM</sub> =2 I <sub>TAV</sub> ; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс	
<b>Тепловые параметры</b>					
T <sub>stg</sub>	Температура хранения	°C	-40 ÷ 125		
T <sub>j</sub>	Температура р-п перехода	°C	-40 ÷ 125		
<b>Механические параметры</b>					
a	Ускорение	m/c <sup>2</sup>	50		

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение и наименование характеристики		Ед. изм.	Значение	Условия измерения		
<b>Характеристики в проводящем состоянии</b>						
U <sub>TM</sub>	Импульсное напряжение в открытом состоянии, макс	В	1.85	T <sub>j</sub> =25 °C; I <sub>TM</sub> = 1570 A		
U <sub>T(TO)</sub>	Пороговое напряжение, макс	В	1.10	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; 0.5 π I <sub>TAV</sub> < I <sub>T</sub> < 1.5 π I <sub>TAV</sub>		
r <sub>T</sub>	Динамическое сопротивление в открытом состоянии, макс	МОм	0.400			
I <sub>L</sub>	Ток включения, макс	mA	1500	T <sub>j</sub> =25 °C; U <sub>D</sub> =12 В; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс		
I <sub>H</sub>	Ток удержания, макс	mA	300	T <sub>j</sub> =25 °C; U <sub>D</sub> =12 В; управление разомкнуто		
<b>Блокирующие характеристики</b>						
I <sub>DRM</sub> , I <sub>RRM</sub>	Повторяющийся импульсный обратный ток и повторяющийся импульсный ток в закрытом состоянии, макс	mA	250	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>D</sub> =U <sub>DRM</sub> ; U <sub>R</sub> =U <sub>RRM</sub>		
(dv <sub>D</sub> /dt) <sub>crit</sub>	Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии, мин	В/мкс	1000	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>D</sub> =0.67·U <sub>DRM</sub> ; управление разомкнуто		
<b>Характеристики управления</b>						
U <sub>GT</sub>	Отпирающее постоянное напряжение управления, макс	В	4.00 2.50 2.00	T <sub>j</sub> = T <sub>j</sub> min T <sub>j</sub> =25 °C T <sub>j</sub> = T <sub>j</sub> max	U <sub>D</sub> =12 В; I <sub>D</sub> =3 A; Постоянный ток управления	
I <sub>GT</sub>	Отпирающий постоянный ток управления, макс	mA	400 250 200	T <sub>j</sub> = T <sub>j</sub> min T <sub>j</sub> = 25 °C T <sub>j</sub> = T <sub>j</sub> max		
U <sub>GD</sub>	Неотпирающее постоянное напряжение управления, мин	В	0.35	T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; U <sub>D</sub> =0.67·U <sub>DRM</sub> ;		
I <sub>GD</sub>	Неотпирающий постоянный ток управления, мин	mA	15.00	Постоянный ток управления		
<b>Динамические характеристики</b>						
t <sub>gd</sub>	Время задержки включения	мкс	3.00	T <sub>j</sub> =25 °C; V <sub>D</sub> =0.4·U <sub>DRM</sub> ; I <sub>TM</sub> =I <sub>TAV</sub> ; Импульс управления: I <sub>G</sub> =2 A; t <sub>GP</sub> =50 мкс; di <sub>G</sub> /dt≥1 A/мкс		
t <sub>q</sub>	Время выключения, макс	мкс	400	dv <sub>D</sub> /dt=50 В/мкс; T <sub>j</sub> =T <sub>j</sub> max; I <sub>TM</sub> = I <sub>TAV</sub> ; di <sub>R</sub> /dt=-10 A/мкс; U <sub>R</sub> =100 В; U <sub>D</sub> = 0.67 U <sub>DRM</sub> ;		
<b>Тепловые характеристики</b>						
R <sub>thjc</sub>	Тепловое сопротивление р-п переход-корпус, макс			180 эл. град. синус; 50 Гц (t <sub>p</sub> =10 мс)		
	на модуль	°C/Вт	0.0250			
	на позицию	°C/Вт	0.0500			
R <sub>thch</sub>	Тепловое сопротивление корпус-охладитель, макс					
	на модуль	°C/Вт	0.0080			
	на позицию	°C/Вт	0.0160			
<b>Характеристики изоляции</b>						
U <sub>ISOL</sub>	Электрическая прочность изоляции	кВ	3.00	синус; 50 Гц;		
			3.60	действующее значение t=1 с		
<b>Механические характеристики</b>						
M <sub>1</sub>	Момент затяжки основания (M8) <sup>1)</sup>	Нм	9.00	Допуск ± 15%		
M <sub>2</sub>	Момент затяжки выводов (M12) <sup>1)</sup>	Нм	18.00	Допуск ± 10%		
w	Масса, тип	г	4000			

МАРКИРОВКА	ПРИМЕЧАНИЕ																				
<table border="1" data-bbox="112 132 790 197"> <tr> <td>MT</td><td>3</td><td>-</td><td>500</td><td>-</td><td>36</td><td>-</td><td>D</td><td>-</td><td>УХЛ2</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td><td>5</td><td></td><td>6</td> </tr> </table> <p>         1. Тиристорный модуль (МТ)          Тиристорно-диодный модуль (МТ/Д)          Диодно-тиристорный модуль (МД/Т)          2. Схема включения          3. Средний прямой ток, А          4. Класс по напряжению          5. Тип корпуса (M.D)          6. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ2       </p>	MT	3	-	500	-	36	-	D	-	УХЛ2	1	2		3		4		5		6	<p><sup>1)</sup> Резьба должна быть смазана</p>
MT	3	-	500	-	36	-	D	-	УХЛ2												
1	2		3		4		5		6												